## Тест по "Материалознание" примерен вариант 1

Група	Име	Фамилия	Факултетен номер	Дата

Раздел	I	П	Ш	IV	Общо
Точки (тах)	32	33	10	25	100
Получени точки					

## І. ЗАГУБИ В ДИЕЛЕКТРИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ

- 1. Дайте дефиниция за диелектрични загуби.
- $\bigcirc$

- 6 т.
- 2. Величината тангенс на ъгъла на диелектричните загубите  $tg\delta = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon}$  отразява загубите на енергия, появили се в резултат от въздействието на:
  - а) постоянно електрическо поле;

3 т.

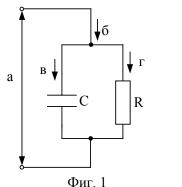
- б) променливо електрическо поле;
- в) не се влияят от вида на електрическото поле.

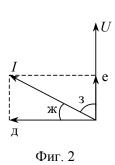
Опишете елементите във формулата.

3. Паралелната еквивалентна схема, отразяваща загубите в диелектричните материали е показана на фиг. 1, а съответстващата й векторна диаграма на напрежението и токовете - на фиг. 2. Означете елементите от схемата и от диаграмата.

5 т.







- 4. Кой от изброените процеси, протичащ в диелектричните материали под влияние на електрическото поле не е придружен от загубите на енергия?
  - а) бързи поляризации;

1 т.

- б) бавни поляризации;
- в) електропроводимост.
- 5. Специфичните загуби  $P_V$  в диелектричен материал се изчисляват чрез израза: 4 т.

(a) 
$$P_V = \frac{P}{V} = \frac{U^2 \omega C t g \delta}{S d} = E^2 \omega \varepsilon_0 \varepsilon_r t g \delta$$
,  $W_{\text{m}^3}$ ;

6) 
$$P_V = \frac{P}{S} = \frac{U^2 \omega C t g \delta}{S} = U^2 \frac{\omega \varepsilon_0 \varepsilon_r t g \delta}{d}, W_{\text{m}^2};$$

B) 
$$P_V = \frac{P}{d} = \frac{U^2 \omega C t g \delta}{d} = E^2 \omega \varepsilon_0 \varepsilon_r t g \delta$$
, W/m.

Опишете елементите във вярната формулата и дайте дименсиите им.

- 6. С тангенса на ъгъла на диелектричните загуби tgδ се оценяват:
  - а) релаксационните загуби;
  - б) комплексните загуби;
  - в) загубите от електропроводност.

1 т.

7. Направете анализ на честотната зависимост на  $tg\delta = \frac{N\alpha_0\omega\tau}{\varepsilon_0\left(1+\omega^2\tau^2\right)}$ :

 $\omega \to 0$  ,  $\mathbf{T0} \Rightarrow \varepsilon_r t g \delta \to 2$   $\Rightarrow t g \delta \to 0$   $\Rightarrow t g \delta$ 

- 8. Температурната зависимост на  $tg\delta$  се определя от температурната зависимост на:
  - а) времето за релаксация т;
  - б) диелектричната проницаемост  $\varepsilon_r$ ;
  - в) активните загуби P.
- 9. Времето на релаксация τ:

1 т.

- а) намалява при повишаване на температурата;
- б) се увеличава при повишаване на температурата;
- в) не зависи от температурата.
- 10. Активните загуби от електропроводимост P се изчисляват по израза:

(a) 
$$P = \frac{U^2}{R_{vo}}$$
; 3 T.

- б)  $P = R_{us}U^2$ ;
- $P = R_{u3}I_{non}^2.$

Опишете елементите във вярната формулата и дайте дименсиите им.

- 11. Йонизационните загуби могат да се определят от израза: 3 т.
  - a)  $P_{\check{u}oh} = A_1 f(U U_{\check{u}oh})^3$ ;
  - б)  $P_{iioh} = A_1 f (U_{iioh} U)^3$ ;
  - B)  $P_{\tilde{u}oh} = A_1 f (U + U_{\tilde{u}oh})^3$ .

Опишете елементите във вярната формулата.

## ІІ. ПРОВОДНИКОВИ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ

- 1. Проводниковите материали с електронна проводимост се наричат още:
  - а) проводници от І род;

1 т.

- б) проводници от II род;
- в) проводници от III род.
- 2. Обяснете е строежа на металите и произхода на колективните електрони. 6 т.



3. Подвижността но електроните в металите може да се изчисли от израза:

a) 
$$\mu = \frac{2mv_{\rm T}}{e\lambda_{\rm cp}}$$
,

3 т.

$$6) \mu = \frac{e\lambda_{\rm cp}}{2mv_{\rm T}},$$

B) 
$$\mu = \frac{e}{2mv_{\rm T}}$$
,

Опишете елементите във вярната формулата.

4. Вероятността за заемане на енергетично ниво се описва от разпределението на Ферми по формулата: 3 т.

a) 
$$P(W) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{W + W_F}{kT}\right)}$$
,

(6) 
$$P(W) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{W - W_F}{kT}\right)}$$
,

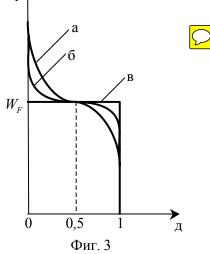


B) 
$$P(W) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{W - W_F}{3kT}\right)}$$
,

Опишете елементите във вярната формулата.

5. Ако разпределението на Ферми има вида показан на фиг. 3, опишете елементите от графиката: Г↑ 4 т.

- a -
- б-
- В-
- Γ-
- Д-



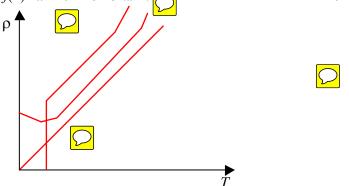
6. Температурният коефициент на специфично съпротивление се дава с общата формула  $\alpha_{\rho}$  =...... и има дименсия ....... 4 т.



7. Законът на Видеман-Франц се описва от израза  $h_T = aT\sigma$ . Опишете елементите във формулата и дайте дименсиите им (без a - константата на Видеман-Франц).



8. Постройте графично и обяснете температурната зависимост на специфично съпротивление  $\rho = f(T)$  на чистите метали. 6 т.



- 9. При увеличаване на концентрацията на примесите в металите:
  - а) специфичното им съпротивление ρ се увеличава;
  - б) специфичната им проводимост σ се увеличава;
  - в) специфичното им съпротивление  $\rho$  не се променя.
- 10. При контакт между два метала с различно ниво на Ферми започва преминаването на електрони от:
  - а) метала с по-високо ниво на Ферми към метала с по-ниско ниво на Ферми;
  - б) метала с по-ниско ниво на Ферми към метала с по-високо ниво на Ферми;
  - в) не е свързано с нивото на Ферми.
- 11. Термо-електродвижещото напрежение се нарича потенциалната разлика, възникнала поради:
- а) разлика в интензитетите на електрическото поле в двата края на метален проводник;
- б) разлика в интензитетите на магнитното поле в двата края на метален проводник;
  - в) разлика в температурата в двата края на метален проводник.

## ІІІ. ПОЛУПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ

1. В таблицата са дадени някои от основните параметри на германий и силиций. Отбележете параметъра, който в най-голяма степен определя работната температура на полупроводниковия материал:

2 т.

	Ge	Si	
Широчина на забранената зона, eV	0,665	1,12	
Подвижност на електроните, $m^2/V$ .s	0,39	0, 14	
Подвижност на дупките, $m^2/V$ .s	0,19	0,05	
Специфично съпротивление, Ω.m	0,68	$2.10^{3}$	
Температура на топене, °С	936	1414	

2. Попълнете валентността на елементите A и B, които участват в полупроводниковите химически съединения: 6 т.

Посочете примери на полупроводникови съединения от означените типове.

1 т.

3. Чистотата на полупроводниковите материали се измерва с:

- а) процент на примесите;
- б) промил на примесите;
- в) брой на примесните атоми на единица обем.

4. Методът за изтегляне на монокристал от стопилка (метод на Чохралски) се използва за получаване на монокристали: 1 т.

- а) само от силиций;
- б) само от германий;
- в) от различни полупроводникови материали.

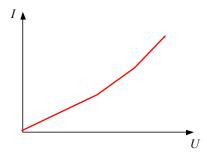
**IV. КОНДЕНЗАТОРИ** 

1. Кои от изброените електронни градивни елементи са активни? 3 т.

- а) резистори;
- б) кондензатори;
- в) транзистори;
- г) диоди;
- д) бобини;
- е) тиристори.

Въпросът може да има повече от един верен отговор.

2. Начертайте волт-амперната характеристика на нелинеен електронен 3 т. елемент.



3. Дайте дефиниция за променлив кондензатор. —



4 T.

1 т.

разбира номинално напрежение кондензатора 4 т. ••••••



5. Времеконстантата на кондензатора се изчислява по израза:

- a)  $\tau = I_{vm}C_N$ ;
- $\delta) \tau = \frac{I_{ym}}{C_{yy}};$
- $\mathbf{B)} \ \tau = R_{u3} C_N \ .$

Опишете елементите във вярната формула и дайте дименсиите им.

6. Имайки предвид израза за пълното съпротивление на кондензатора  $|Z_C| = \sqrt{r^2 + \left(\omega L_C - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$  , начертайте последователната му еквивалентна схема. Опишете елементите във формулата.

7. Основната особеност на електролитните кондензатори е в това, че те притежават: 1 т.

- а) много малък температурен коефициент на специфичния капацитет;
- б) много голям специфичен капацитет;
- в) много голямо номинално съпротивление.

8. Като диелектрик в електролитните кондензатори се използва: 1 т.

- а) кондензаторни керамики;
- б) електролит със специален състав;
- в) оксиди на вентилните метали (Al, Ta, Nb).

3 т.